



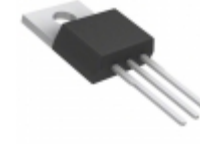


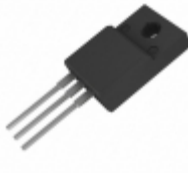

	<h2 style="color: red;">FQP9N90C</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQP9N90C</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 8A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP9N90C.pdf 2.FQP9N90C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 29299 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP9N90C
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 8A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	29299 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	205W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2730pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FQP9N90C ist neu im Original, Suche FQP9N90C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP9N90C Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQP9N90C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQP9N90C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-220	 FQP9N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A TO-220	 FQP9N90CT Fairchild/ON Semiconductor FQP9N90CT FAIRCHILD	 FQP9P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 9.4A TO-220
 FQP9P25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 9.4A TO-220	 FQP9N65C VB FQP9N65C VB	 FQPF10N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 6.8A TO-220F	 FQP9N50C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A TO-220

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP7N65C	↔ FQP7N65C	⇒ FQP7N80C	D FQP7N80C	⇒ FQP85N06
⊣ FQP85N06	⊗ FQP8N50C	D FQP8N60C	⇒ FQP8N60C	⇒ FQP8N65C
⊗ FQP8N80C	⊣ FQP8N80C	⊗ FQP8N90C	↔ FQP8N90C	⇒ FQP90N08
D FQP90N08	⊗ FQP90N10V2	⊣ FQP90N10V2	⊗ FQP9N08L	⇒ FQP9N08L
⇒ FQP9N25C	↔ FQP9N25C	⊗ FQP9N50C	⊣ FQP9N50C	⇒ FQP9N65C
↔ FQP9N90C	⇒ FQPF10N20	D FQPF10N20	⊗ FQPF10N20C	⊣ FQPF10N20C
⊗ FQPF10N50CF	D FQPF10N50CF	⇒ FQPF10N60	↔ FQPF10N60C	⇒ FQPF10N60C
⊣ FQPF10N60CF	⊗ FQPF10N60CF	↔ FQPF10N65C	⇒ FQPF11N40	⇒ FQPF11N40C
⊗ FQPF11N40C	⊣ FQPF11N50C	⊗ FQPF11N50CF	D FQPF11N50CF	⇒ FQPF11N60
↔ FQPF11N60C	⊗ FQPF11N65C	⊣ FQPF11P06	⊗ FQPF11P06	⇒ FQPF12N50C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited